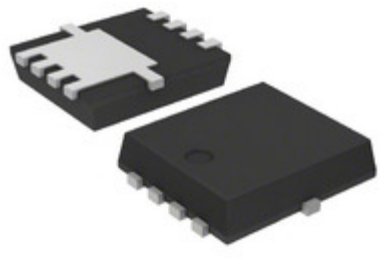

	<h2 style="color: red;">TPH2R306NH,L1Q</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TPH2R306NH,L1Q</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N CH 60V 60A SOP ADV
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TPH2R306NH,L1Q.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 122873 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	TPH2R306NH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N CH 60V 60A SOP ADV
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	122873 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

TPH2R306NH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH2R306NH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH2R306NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TPH2R306NH,L1Q E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPH2R506PL,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage X35 PB-F POWER MOSFET TRANSISTOR</p>	 <p><b>TPH2R003PL</b> QQ2850920316 TPH2R003PL QQ2850920316</p>	 <p><b>TPH2R306NH</b> TOSHIBA TPH2R306NH TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH2900ENH,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 200V 33A SOP8</p>
 <p><b>TPH2900ENH</b> TOSHIBA TOSHIBA SOP-8</p>	 <p><b>TPH2R306NH,L1Q(M)</b> TOSHIBA TPH2R306NH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH2R608NH</b> TOSHIBA TPH2R608NH TOSHIBA</p>	 <p><b>TPH2R805PL</b> QQ2850920316 TPH2R805PL QQ2850920316</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH2R306NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH2R306NH,L1Q Datenblatt	TPH2R306NH,L1Q-Datenblätter	TPH2R306NH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TPH2R306NH,L1Q Electronic	TPH2R306NH,L1Q-Komponenten	TPH2R306NH,L1Q-Verteiler	TPH2R306NH,L1Q-Bild	TPH2R306NH,L1Q-Teil
TPH2R306NH,L1Q Preis	TPH2R306NH,L1Q Hersteller	TPH2R306NH,L1Q Bild	TPH2R306NH,L1Q Aktie	TPH2R306NH,L1Q Inventar
TPH2R306NH,L1Q Neu	TPH2R306NH,L1Q Original	TPH2R306NH,L1Q garantiert	TPH2R306NH,L1Q RFQ	TPH2R306NH,L1Q Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited